

محمد صادق ابریشمیان در سال ۱۳۲۵ در همدان متولد شد. مهندسی مخابرات را در سال ۱۳۵۰ و کارشناسی ارشد را در سال ۱۳۵۷ از دانشگاه نورتزوپ آمریکا اخذ نمود. دوره دکترا را در دانشگاه کالیفرنیا - ایروپاین و دانشگاه برادفورد انگلستان پیاپیان رسانید. از سال ۱۳۵۲ تا کنون در استخدام رسمی دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی بوده و اکنون دانشیار گروه مخابرات آن دانشگاه مستند و بندریس و تحقیق مشغول می باشد. ایشان تا کنون حدود ۲۴ مقاله در مجلات علمی - پژوهشی بین المللی و ۳۰ مقاله در کنفرانس ها ارائه و به چاپ رسانیده اند. گرایش هایی مورد علاقه ایشان، پراش امواج، روش های عددی در الکترومغناطیسی و فوتونیک کریستال ها می باشد.



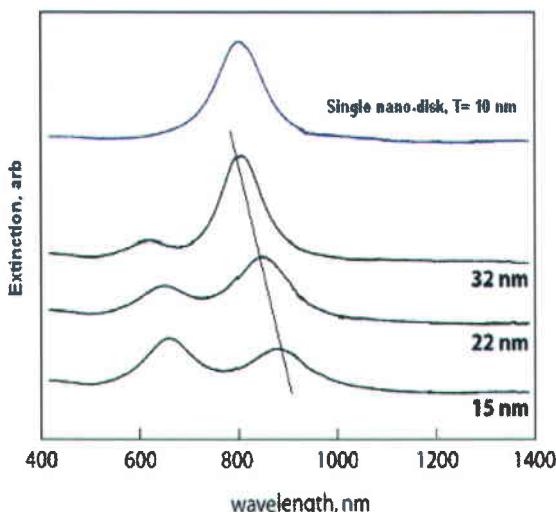
نصرت ا... گرانپایه متولد ۱۳۳۱ تهران، مدرک-های کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکترای خود را به ترتیب از دانشکده مخابرات، دانشکده صدا و سیما و دانشکده برق دانشگاه NSW استرالیا در سال های ۱۳۵۹، ۱۳۵۶ و ۱۳۵۴ به دست آورد. در سال ۱۳۵۴ به دلیل شاگرد اول بودن به عنوان کارشناس آموزشی در دانشکده مخابرات استخدام شد. پس از دریافت مدرک کارشناسی ارشد و دکترا به ترتیب به رتبه مری و استادیار ارتقاء یافت. از سال ۱۳۵۹ به طور همزمان به کار تدریس و تحقیق مشغول بوده است. زمینه های تحقیقاتی مورد علاقه هی وی فیبر و ادوات مخابرات نوری، تقویت کننده های فیبر نوری، اثرات غیر خطی در فیبر نوری و ... بوده است. که منجر به چاپ بیش از ۱۸ مقاله در مجله های علمی و ۵ مقاله در کنفرانس های داخلی و خارجی شده است. گرانپایه ضمن انجمن های مهندسی برق و الکترونیک ایران و اپتیک و فوتونیک ایران، IEEE و انجمن فوتونیک IEEE است.



- [5] P. N. Parsad, *Nanophotonics*, John Wiley & Sons, New Jersey, 2004.
- [6] C. F. Bohren and D. R. Huffman, *Absorption and Scattering of Light by Small Particles*, John Wiley & Sons, 1983.
- [7] S. A. Maier, P. G. Kik, and H. Atwater, "Optical pulse propagation in metal nanoparticle chain waveguide," *Phys. Rev. B.*, vol. 67, 205402, 2003.
- [8] K. Li, M. I. Stockman, and D. J. Bergman, "Self-similar chain of metal nanospheres as an efficient nanolens," *Phys. Rev. Lett.*, vol. 91, 227402, 2003.
- [9] D. R. Smith, J. B. Pendry, and M. C. K. Wiltshire, "Metamaterial and negative refractive index," *Science*, vol. 305, pp. 788-792, 2004.
- [10] V. M. Shalaev, W. Cai, U. K. Chettiar, et. al., "Negative index of refraction in optical metamaterials," *Opt. Lett.* 30, 3356-3358, (2005).
- [11] H. Ditlbacher, J. R. Krenn, G. Schider, A. Leitner, and F. R. Aussenegg, "Two-dimensional optics with surface plasmon polaritons," *Appl. Phys. Lett.* 81, 1762, (2002).
- [12] C. Jung, S. Yee, and K. Kuhn, "Integrated optics waveguide modulator based on surface plasmon resonance," *IEEE J. Lightwav. Technol.*, vol. 12, pp. 1802, 1994.
- [13] S. I. Bozhevolnyi, V. S. Volkov, E. Devaux, J.-Y Laluet, and T. W. Ebbesen, "Channel plasmon subwavelength waveguide components including interferometers and ring resonators," *Science*, vol. 440, pp. 508-511, 2006.
- [14] M. L. Brongersma, J. W. Hartman, and H. A. Atwater, "Electromagnetic energy transfer and switching in nanoparticle chain arrays below the diffraction limit of light," *Phys. Rev. B*, vol. 62, pp. 356, 2000.
- [15] T. Pakizeh, M. S. Abrishamian, N. Granpayeh, A. Dmitriev, M. Käll, "Magnetic-field enhancement in gold nanosandwiches," *Opt. Express*, vol. 14, pp. 8240-8246, 2006.
- [16] A. Dmitriev, T. Pakizeh, M. Käll, and D. S. Sutherland, "Surface plasmon hybridization in gold-silica-gold nanosandwiches," *Small* 3, 294-299, (2006).
- [17] A. Taflove and S. C. Hagness, *Computational Electrodynamics: The Finite-Difference Time-Domain Method*, Artech House, 2005.
- [18] D. M. Sullivan, *Electromagnetic Simulation Using the FDTD Method*, IEEE Press, 2000.
- [19] D. F. Kelly and R. J. Luebers, "Piecewise Linear Recursive Convolution for Dispersive Media Using FDTD," *IEEE Trans. Antenna Propagat.*, vol. 44, pp. 792, 1996.

توكل پاکيزيه، متولد ۱۳۵۶ در همدان، در سال ۱۳۸۵ دکترای خود را در رشته مهندسی برق - مخابرات از دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی با درجه عالی دریافت کرد. ایشان دوره فوق دکتری خود را از سال ۱۳۸۸ تا ۱۳۸۶ در رشته نانوفوتونیک و نانو اپتیک در دانشگاه صنعتی چالدران - سوئد گذرانید. از سال ۱۳۸۱ تا ۱۳۸۴ ایشان به عنوان پژوهشگر در گروه فن اوری ارتباطات نوری در مرکز تحقیقات مخابرات ایران مشغول شده بود. جایزه دانشمند جوان (YSA) در تئوری الکترومغناطیس در سال ۱۳۸۳ از طرف سازمان بین المللی URSI در سمپوزیوم EMT-S در ایتالیا به او تعلق گرفت. دکتر پاکيزيه در زمينه های نانopolasmونيك، الکترومغناطیس، نانوفوتونیک، نور موجی و ارتباطات نوری فعالیت های پژوهشی می گند.





شکل ۴: طیف پاسخ اندازه‌گیری شده برای نانوفیلترهای نوری ساخته شده و شیفت قله نوسان ساختار با تغییر فاصله دو نانودیسک (S) از ۲۲ تا ۱۵ نانومتر و در مقایسه با طیف پاسخ یک تک نانودیسک با ضخامت ۱۰ نانومتر.

۵- جمع‌بندی

یک نانوساختار ساده بر اساس یک زوج نانودیسک از جنس طلا با تحریک انتهایی بررسی شده و کاربرد آن در پالایش بازه نوری برای اولین بار مطرح شد. یک نانوفیلتر مؤثر بر اساس نوسان پلاسمون‌های سطحی و اندرکنش الکترومغناطیسی آنها در فرکانس‌های نوری طراحی و با استفاده از تکنیک نانولیتوگرافی حفره-ماسک (HM) ساخته شده است. پاسخ فرکانسی نانوفیلتر معروفی شده قابل تنظیم در حوزه طول موج‌های نور مرئی و مخابراتی است.

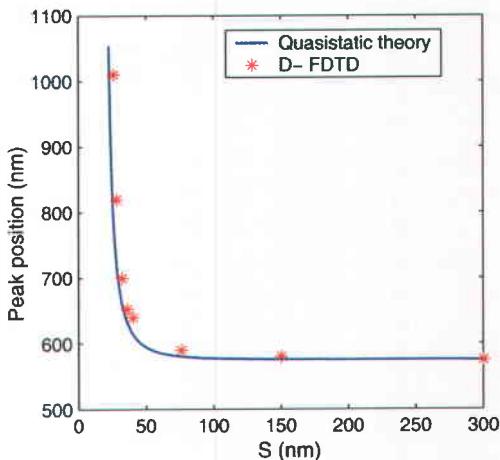
سپاس‌گذاری

از همکاری‌ها و راهنمایی‌های ارزشمند آقای پروفسور میکائیل شل و دکتر آلکساندر دمیتریف در دانشگاه صنعتی چالمرز سپاس‌گذاری می‌شود.

مراجع

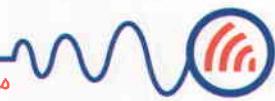
- [1] E. Ozbay, "Plasmonics: Merging photonics and electronics at nanoscale dimensions," *Science*, vol. 311, pp. 189-193, 2006.
- [2] W. L. Barnes, A. Dereux, and T. W. Ebbesen, "Surface plasmon subwavelength optics," *Nature*, vol. 424, pp. 824-830, 2003.
- [3] J. R. Krenn, H. Ditlbacher, G. Schider, A. Hohenau, A. Leitner, and F. R. Aussenegg, "Surface plasmon micro- and nano-optics," *J. Micros.*, vol. 209, pp. 167, 2003.
- [4] S. A. Maier, M. L. Brongersma, P. G. Kik, S. Meltzer, A. A. G. Requicha, and H. A. Atwater, "Plasmonics: A route to nanoscale optical devices," *Adv. Mater.*, vol. 13, pp. 1501, 2001.

شکل (۶) نتایج آزمایشگاهی بدست آمده برای پاسخهای فرکانسی نانوفیلترهای ساخته شده با روش توصیفی بالا برای چندین حالت (با تغییر فاصله بین دو نانودیسک از ۳۲ به ۱۵ نانومتر) نشان می‌دهد. برای نمونه طیف پاسخ فرکانسی یک تک نانودیسک طلایی با قطر ۱۰۰ نانومتر و ضخامت ۱۰ نانومتر نیز در شکل آورده شده است. حالت نوسانی و فیلتری در ساختار و شیفت محل قله نوسان پلاسمون‌های تحریک شده بر روی سطح فلزی نانودیسک‌ها، به سمت طول موج‌های بلندتر با تغییر فاصله زوج نانودیسک در شکل (۶) مشخص است. همانطوریکه در شکل (۳c) نشان داده شده، ساختار ساخته شده از چندین زیرنانوساختار (نانوفیلتر) به صورت یک آرایه نامنظم تشکیل شده است. فاصله‌ی بین زیرنانوساختارها از هم حدود ۲۰۰-۱۵۰ نانومتر تخمین زده می‌شود. از این‌رو تزویج الکترومغناطیسی ضعیفی بین نزدیکترین آنها وجود دارد که باعث افزایش میرایی نوسان مدهای الکترومغناطیسی شده و در نتیجه پهن تر شدن عرض باند می‌شود.

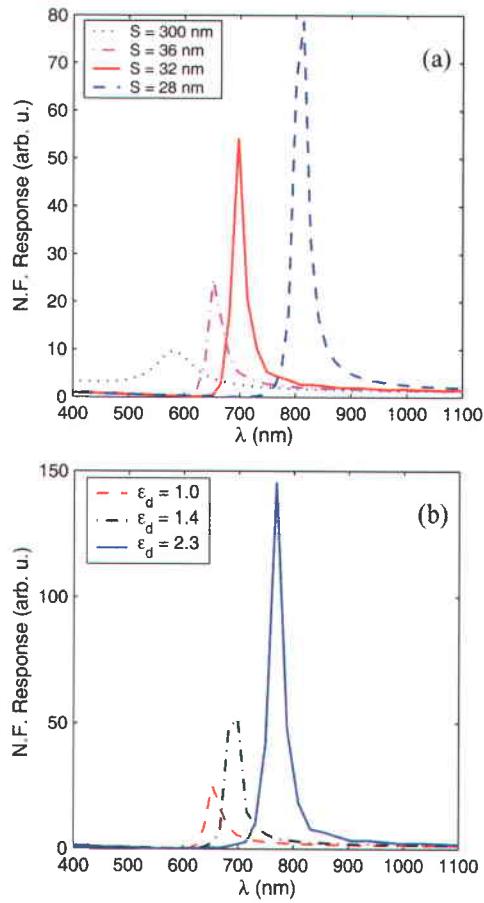


شکل ۵: تنظیم شیفت قله نوسان ساختار با تغییر فاصله دو نانودیسک (S). محاسبه شده با روش D-FDTD و مقایسه شده با تئوری تقریب الکتریسیته شباهنگان.

در محاسبه‌های FDTD تنها یک نانوفیلتر در نظر گرفته شده و بنابراین این تزویج ضعیف در نظر گرفته نشده است. قابل ذکر است که اگر یک آرایه منظم با تناوب مشخص از نانوفیلترها فرض کنیم، تزویج مذکور که در حوزه‌ی میدان دور می‌باشد منجر به ظهور مرتبه‌های تفرق در پاسخ طیفی ساختار می‌شود و نمی‌توان از آن صرف نظر کرد. ولی در یک آرایه‌ی نامنظم اثرات تزویج بین زیرنانوساختارها قابل صرفنظر کردن است. تغییر اندازه کل ساختار بر روی پاسخ فرکانسی تأثیر می‌گذارد. افزایش قطرهای نانودیسک‌ها باعث شیفت محل نوسان پلاسمون‌ها و پاسخ فرکانسی ساختار به طول موج‌های بلندتر می‌شود. از این‌رو امکان بررسی ساختار برای کاربردهای مخابراتی وجود دارد. یکی از مشکلات این طرح تلفات اهمی ذاتی در نانودیسک‌های فلزی است. اثر پارامترهای مختلف در طرح پیشنهادی و عملکرد نوری آن و همچنین پتانسیل‌های دیگر آن در کاربردهای دیگر در دست مطالعه و بررسی بیشتر است.



شیشه‌ای (ضخامت ۱ میلی متر، VWRI) پخش شده که بستر مناسبی برای خود جانشینی ذرات کولوئیدال پلی‌استرین باردار شده (اندازه ۱۰۷ نانومتر، Molecular Probes Inc.) است. نیروی الکتریسیته ساکن باعث ایجاد یک آرایه از این ذرات می‌شود. یک لایه نازک (۱۰ نانومتر) ورقه طلا در یک خلاء بالا به صورت حرارتی لایه نشانی می‌شود (AVAC HV6000). سپس با چسب نواری می‌توان پلی‌استرین را برداشت و یک سری نانوحفره در فیلم طلایی و نشسته برروی PMMA باقی گذاشت. این الگو به عنوان یک ماسک برای حک کردن راکتیو یونی (PMMA BathTop VII, 50 W) (PlasmaTherm) که زیر نشانی ترکیبات آن (Au-SiO₂-Au) به روش تبخیر^{۱۷} با برتو الکترونی بکار می‌رود. پس از موارد جزئی مراحل دیگر، نانوساختار ساخته شده (نانوساندویچ) و همگن بودن نانودیسک‌های بوجود آمده، با کمک Digital Instr. Nanoscope (AFM) (III), Digital Instr. Santa Barbara, CA (SEM) (JEOL JSM-6301F) قابل مشاهده، بررسی و تأیید است (شکل ۲C). اندازه‌گیری طیف پاسخ فرکانسی با استفاده از یک طیف‌نگار نوری (CARY 500) در باند نوری ۳۵۰-۲۰۰۰ نانومتر انجام می‌گیرد.



شکل ۴: پاسخ میدان نزدیک و طیف‌های شدت میدان با تغییر (a) فاصله دو نانودیسک (S) از ۳۰۰ تا ۲۸ نانومتر و (b) گذردهی الکتریکی نسبی فضای بین دو نانودیسک از ۱ تا ۲/۳، محاسبه شده با روش D-FDTD

17 Evaporation

$$\varepsilon(\omega) = \varepsilon_{\infty} + \frac{\omega_p^2}{\omega(j\gamma_c - \omega)} + \sum_{n=1}^{\infty} \frac{G_n \omega_n^2}{(\omega^2 - \omega_n^2) + j\omega\Gamma_n} \quad (7)$$

که مشخصات نوسان‌کننده Γ_n لورنسی هستند و ε_{∞} نرخ برخورد الکترون‌ها در مدل درود است. با توجه به شکل رابطه مشخص است که اگر از کانولوشن یا تبدیل Z استفاده شود، الگوریتم FDTD به دو تأخیر Δt برای اصلاح میدان نیاز خواهد داشت. بنابراین الگوریتم روشن D-FDTD با مدل لورنس-درود، پیچیده‌تر از الگوریتم استاندارد یا D-FDTD با مدل درود بوده و همچنین به حافظه بیشتری بدلیل طولانی‌تر شدن زمان محاسبه، احتیاج دارد. برای دخالت دادن هر نوسان‌کننده لورنسی در مدل و الگوریتم محاسبه تدریجی بایستی چهار متغیر کمکی تعریف شود که اگر فرض کنیم که پنج نوسان‌کننده لورنسی برای مدل رفتار الکتریکی ساختار لازم است، در مجموع بیست متغیر جدید باید به متغیرها اضافه شده و به آنها حافظه اختصاص داده شود که سرعت محاسبه را برای ساختارهای سه بعدی به شدت تحت تاثیر خود قرار می‌دهند.

سلول‌بندی حوزه حل عددی $90 \times 90 \times 80$ در نظر گرفته شده که با تغییر فاصله نانودیسک‌ها سلول‌بندی در راستای Z نیز تغییر داده می‌شود. در محاسبات انجام شده اندازه سلول‌ها در سه راستا برابر و $\Delta x = \Delta y = \Delta z = 4$ nm است. اندازه نمو زمانی نیز طوری اختیار می‌شود که شرط پایداری حفظ شود. از شرط مرز جذبی لایه‌های تطبیق کامل (PML) برای محدود کردن حوزه حل در کنارهای استفاده شده است. با بکارگیری تبدیل فوریه برروی داده‌های حوزه زمان می‌توان پاسخ فرکانسی ساختار را محاسبه کرد. طیف افزونگی میدان در روی سطح یک نانوکره طلایی با شاعع ۳۰ نانومتر در شکل (۳) نشان داده شده است. از این طیف مشخص می‌شود که طول موج نوسان LSP‌ها در نانوکره ۵۵۰ نانومتر (محل قله افزونگی) است.

یکی از پارامترهای نانوفیلتر بررسی شده، فاصله بین دو نانودیسک است. کم کردن این فاصله تا حد عمق نفوذ پلاسمون‌ها در دیسک‌ها باعث جابجا شدن پاسخ فرکانسی نانوفیلتر می‌شود. این حالت به خوبی در طیف‌های افزونگی شدت میدان^{۱۵} ساختار با دونانودیسک فلزی با اندازه قطرهای $D_1 = D_2 = 88$ nm و ضخامت‌های $T_1 = T_2 = 24$ nm، با تغییر فاصله از ۳۰۰ تا ۲۸ نانومتر نمایش داده در شکل (۴a)، نشان داده شده است. اثر ضربی شکست یا گذردهی الکتریکی فضای بین دو نانودیسک برروی پاسخ ساختار در میدان نزدیک در شکل (۴b) آورده شده است. شکل (۵) شیفت قله نوسان مود پلاسمونی تحریک شده در ساختار بر اثر تابش یک موج سطحی با تغییر فاصله دونانودیسک (S) را نشان می‌دهد. محدودیت در حافظه و سرعت حل عددی باعث ایجاد محدودیت در شبیه‌سازی ساختارهای مشابه با ابعاد بزرگتر که مناسب برای طول موج‌های مخابرات نوری هستند، می‌شود که با در دست داشتن سوپر کامپیوترا مشکل حافظه و سرعت حل از بین می‌رود.

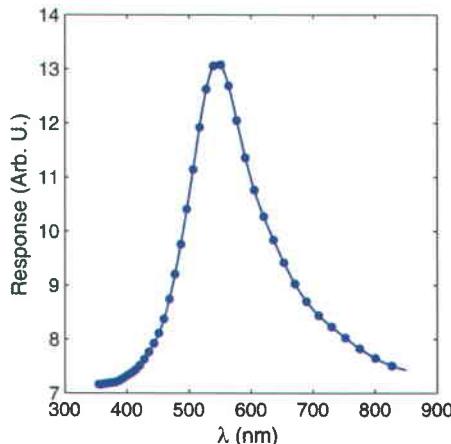
نانوساختار بوسیله تکنیک نانولیتوگرافی^{۱۶} حفره-ماسک (HM) که به عبارتی روش اصلاح یافته لیتوگرافی کولوئیدال محسوب می‌شود، ساخته می‌شود [۱۶]. یک لایه پلی‌متیل متاکریلت (PMMA) (ضخامت ۸۰ نانومتر، 950K PMMA) به صورت یکنواخت روی یک زیرساخت

15 Intensity-enhancement

16 Nanolithography

نوسان الکتریکی در نانو دیسک است و می‌توان آنرا با یک خازن الکتریکی قوی معادل کرد. نوسان مغناطیسی که در بین دو نانو دیسک اتفاق می‌افتد، خاصیتی شبیه خاصیت مداری یک سلف را دارد (شکل ۲b)). امکان ایجاد یک حلقه جریان الکتریکی مجازی در نانوساختار مشکل از یک نانو دیسک وجود دارد. یک حلقه جریان الکتریکی دارای یک ممان مغناطیسی است که اندازه آن متناسب با اندازه جریان و سطح مقطع حلقه فرضی بوده و پاسخ مغناطیسی ساختار را تضمین می‌کند [۱۵]. وجود یک پاسخ مغناطیسی قوی در ساختار، معادل وجود یک اندوکتانس قوی در مدار معادل الکتریکی ساختار است.

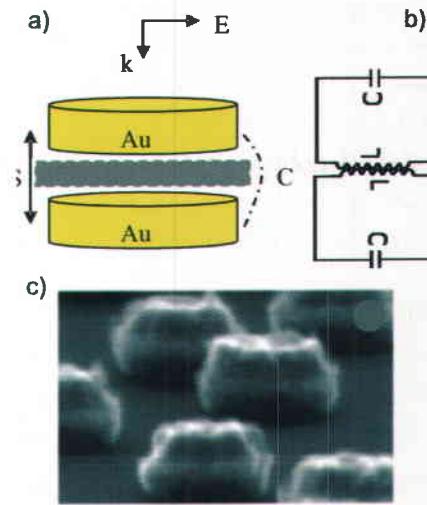
طرح ارائه شده انعطاف‌پذیری خوبی در تنظیم و کنترل پاسخ فرکانسی با تغییر پارامترهای آن دارد. یکی از این پارامترهای مهم و تأثیرگذار در رفتار نانوفیلتر فاصله بین دو نانو دیسک است که مکانیسم اندرنکنش الکترومغناطیسی را تحت تأثیر قرار می‌دهد. پارامتر دیگر ثابت دی الکتریک لایه دی الکتریکی بین دو نانو دیسک است که می‌توان با تغییر آن پاسخ نوری را تغییر داد. اگر ثابت دی الکتریک (یا ضربه شکست n_{eff}) مفروض را بتوان با اعمال ولتاژ با حرارت تغییر داد، آنگاه می‌توان پاسخ نانوفیلتر را به صورت پویا کنترل کرد. بنابراین طرح پیشنهادی یک طرح انعطاف‌پذیر در نوع خود بوده و همچنین قابل ساخت است که ارزشمند بودن آنرا بیش از پیش نمایان می‌کند.



شکل ۳: پاسخ فرکانسی یک نانوکره با شعاع 3° نانومتر و از جنس طلا، طول موج نوسان LSP‌ها ۵۵۰ نانومتر. محاسبه شده با روش D-FDTD است.

۴- شبیه‌سازی الکترومغناطیسی و ساخت نانوفیلتر

روش تفاضل محدود در حوزه زمان معادلات ماکسول را که شامل مشتقات حوزه فضا و زمان هستند، به صورت عددی حل می‌کند. روش حل عددی FDTD یک روش نیرومند برای آنالیز و شبیه‌سازی الکترومغناطیسی ساختارهاست [۱۷-۱۸]. برای شبیه‌سازی محیط‌ها و ساختارهای پاشنده مانند فلزها استفاده از یک مدل مناسب و قابل تطبیق با الگوریتم اصلاح تدریجی میدان‌ها در روش FDTD لازم است. روش FDTD تعمیم یافته برای محیط‌های پاشنده به D-FDTD معروف است [۱۹]. برای فلز طلا مدل لورنس-درود یک مدل مناسب و کامل برای فلز همچون طلا است که ثابت دی الکتریک آن را رابطه (۷) به صورت زیر توصیف می‌شود [۵].



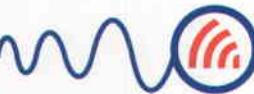
شکل ۲: نمای یک نانوفیلتر نوری. (a) ساختار نانوفیلتر نوری و میدان تابشی، با تغییر ضربه شکست در فضای بین دو دیسک فلزی به صورت پویا می‌توان خواص نوری ساختار را تغییر داد. (b) مدار معادل الکتریکی و (c) تصویر نانوساختار ساخته شده در ریزبینی جاروب الکترونی.

اگر فرض کنیم که یک خازن نوسانی (C_{res}) داریم، آنگاه می‌توان یک حالت نوسانی بدون داشتن یک سلف داشت. به عبارتی دیگر می‌توان رفتار نوری یک نانوذره فلزی (برخاسته از خاصیت الکتریکی و مغناطیسی ذره) را با یک خازن نوسانی به صورت الکتریکی معادل قرار داد. بار الکتریکی ذخیره شده در خازن با رابطه $V = C_{\text{res}} q$ تعیین می‌شود.

رابطه پلاریزاسیون با میدان تابشی ($p_x = \alpha E_x$) معادل رابطه بار الکتریکی جمع شده در دو سر خازن با ولتاژ اعمالی V به آن است. با این معادل‌سازی، به ترتیب میدان تابشی با ولتاژ اعمالی و پلاریزاسیون با بار الکتریکی خازن معادل می‌شود. بنابراین طرفیت خازن (که حالت نوسانی دارد) با قطبی‌شدگی نانوذره هم‌ارز قرار می‌گیرد. به همین صورت می‌توان نشان داد که جریان الکتریکی گذرنده از خازن متغیر (e) با چگالی جریان الکتریکی القایی در نانوذره نیز معادل است، به طوری که: $e = C_{\text{res}} \partial V / \partial t = i_p = \partial p / \partial t$. با قرار دادن یک خازن الکتریکی نوسانی به عنوان مدار معادل الکتریکی یک نانو دیسک، می‌توان برای ساختار نانوفیلتر (شکل ۲a)، مدار معادل الکتریکی شکل (۲b) را در نظر گرفت که شامل یک سلف متغیر موازی با دو خازن الکتریکی است که رابطه فیلتری مشابه رابطه (۶) مربوط به یک مدار نوسانی LC خواهد داشت.

۳- طرح نانوفیلتر نوری

طرح نانوفیلتر پیشنهادی مشکل از یک زوج نانو دیسک فلزی با تحریک انتهایی می‌باشد. شکل (۲) نمای ساختاری یک نانوفیلتر را نشان می‌دهد که رفتار الکترومغناطیسی آن قابل توصیف با جمع آثار یک دوقطبی الکتریکی (P) و یک دوقطبی مغناطیسی (M) است، که حاصل اندرنکش میدان نزدیک دو نانو دیسک فلزی که در فاصله خیلی نزدیکی از هم قرار گرفته‌اند [۱۵]. با بکارگیری روش تقریبی الکتریسیته شبه‌سازکن برای حالت تحریک انتهایی روابط مربوط به قطبی‌شدگی‌های اصلاح شده بدست می‌آیند. مشخص می‌شود که حالت تحریک انتهایی دارای یک ویژگی دو مود هایبرید است [۱۶]. که یک مود مربوط به



مشخصه تلفات ماده (ω)^{۱۶} نیز مقداری خیلی کمتر از ۱ باشد. اگر محیط اطراف نانوکره، هوا فرض شود ($\epsilon_m = 1$) آنگاه شرط نوسان به $\epsilon'_l(\omega_{res}) \approx -2.0$ منتهی می‌شود.

۲-۲ - مدل ساده درود

با بکارگیری مدل ساده درود $(\epsilon_l(\omega) = 1 - (\omega_p/\omega)^2)$ برای فلز که ω_p فرکانس زاویه‌ای پلاسمای ماده است و قرار دادن آن در رابطه (۳)، محل نوسان پلاسمون‌های سطحی برای یک نانوکره فلزی به صورت $\omega_{res} = \omega_p / \sqrt{3}$ بدست می‌آید. اگر شکل نانوکره عوض شود (مثلاً به یک نانودیسک یا بیضیگون)، محل نوسان نیز تغییر پیدا می‌کند که می‌توان با در نظر گرفتن یک ضریب شکل (ℓ)، رابطه محل نوسان را اصلاح کرد، $(\omega_{res} = \omega_p / \sqrt{3\ell})$. قطبی‌شدگی‌ها نیز به صورت زیر تعریف می‌شوند:

$$\alpha_{1,2}(\omega) = 4\pi a_{1,2}^3 \frac{-\omega_p^2}{3\ell_{1,2} \omega^2 - \omega_p^2} \quad (4)$$

فرض می‌شود که دو نانوکره یا نانوذره‌ها دارای اندازه متفاوت هستند ($a_2 \geq a_1$) بنابراین فرکانس نوسان پلاسمون‌های سطحی در آنها به صورت $\omega_{SP_{1,2}} = \omega_p / \sqrt{3\ell_{1,2}}$ در نظر گرفته می‌شود، که ضریب اندازه یا شکل $\ell_1 \geq \ell_2$ هستند.

در بعضی مواد مدل ساده درود یک مدل مناسب نیست، در این حالت ممکن است از مدل لورنس^{۱۷} استفاده شود که در آن رابطه چگالی شار الکتریکی با میدان به صورت رابطه زیر توصیف می‌شود [۵-۶].

$$\mathbf{D} = \left(\epsilon_\infty + \frac{\epsilon_0 \chi_0 \omega_0^2}{\omega_0^2 - \omega^2 + j \Gamma \omega} \right) \mathbf{E} \quad (5)$$

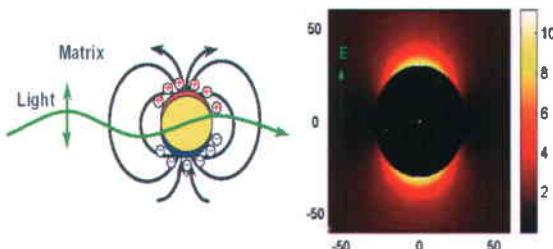
که در آن ω_0 ، χ_0 و Γ به ترتیب فرکانس زاویه‌ای، دامنه و ضریب میرایی نوسان کننده لورنسی هستند. مدل ساده لورنس تا حدی شبیه رابطه مدل درود تلفاتی است و عملکرد کاربردی تر از مدل ساده درود است. با بکارگیری رابطه (۴) یا (۵) می‌توان معادلات دوقطبی‌های تزویج شده را حل کرد و تقریبی از رفتار یک نانوساختار مشکل از دو نانوذره در حال اندرکنش الکترومغناطیسی را بدست آورد.

۲-۳-۲ - خاصیت نوسانی مدار معادل الکتریکی یک نانوذره فلزی

با در نظر گرفتن یک مدار الکتریکی نوسانی متشکل از یک سلف و خازن LC (مدار Z_{LC} ، شکل (۲))، رابطه‌ای که برای امپدانس مدار معادل مدار (Z_{LC}) بدست می‌آید، یک رابطه مشابه با رابطه قطبی‌شدگی یک نانوکره یا نانودیسک فلزی (رابطه (۴)) است.

$$Z_{LC} = \frac{-j \omega L}{\omega^2 LC - 1} \quad (6)$$

رابطه (۶) یک فیلتر باندگز (BPF) ساده را در ذهن تداعی می‌کند.



شکل ۱: تحریک یک دوقطبی الکتریکی قوی در یک نانوذره فلزی و توزیع شدت میدان الکتریکی در نزدیکی یک نانوکره از جنس طلا و با شعاع ۳۰ نانومتر در طول موج ۵۵۰ نانومتر.

فرکانس تشدید به قدرت نیروی بازدارنده وابسته است. این نیرو نیز مشخصاً به فاصله بارهای سطحی از هم (اندازه ذره) و قابلیت قطبی شوندگی محیط بین و اطراف بارها وابسته است. نوسانات بارهای سطحی را تقریباً با یک دوقطبی نوسانی، که امواج الکترومغناطیسی تشعشع می‌کند، مدل می‌کنند. سطح نانوذره‌ها الکترون‌های هدایتی را به داخل ذره سوق می‌دهد و یک نیروی بازدارنده مؤثر را برای ایجاد رفتار تشدیدی در فرکانس دیپل پلاسمون سطحی باعث می‌شوند. شکل (۱) تحریک و نوسان یک پلاسمون ذره‌ای بر اثر یک میدان خارجی و همچنین نموده توزیع شدت میدان الکتریکی در نزدیکی یک نانوکره از جنس طلا در طول موج نوسان ۵۵۰ نانومتر را نشان می‌دهد. اعتبار مدل دوقطبی به ابعاد ذره وابسته است. در این مدل که به مدل ریلی نیز معروف است، ابعاد ذرات باید خیلی کوچکتر از طول موج نور تابشی باشند. اگر ابعاد قبل مقایسه با طول موج باشند، آنگاه این مدل اعتبار خود را از دست خواهد داد [۵، ۶].

اگر فرض کنیم نانوذره مفروض یک نانوکره با شعاع a باشد، آنگاه از الکتریسیته ساکن، میدان پراکنده شده توسط این نانوکره با ضریب گذرهای الکتریکی ϵ_l و قرار گرفته در یک محیط با مشخصه ϵ_m ، به صورت زیر با یک دوقطبی الکتریکی (P)، با قطبی‌شدگی α ، قابل توصیف است [۵]:

$$\mathbf{P} = \alpha \mathbf{E}_{inc}, \quad \alpha(\omega) = 4\pi\epsilon_0 a^3 \frac{\epsilon_l(\omega) - \epsilon_m}{\epsilon_l(\omega) + 2\epsilon_m} \quad (1)$$

رابطه فوق برای قطبی‌شدگی وابسته به فرکانس ($\alpha(\omega)$)، به رابطه کلاسیاس-موسوتی^{۱۲} معروف است [۶]. حالت نوسان وقتی پیش می‌آید که مخرج رابطه (۱) کمینه شود. اگر فرض کنیم نانوکره از جنس فلز است، ضریب گذرهای الکتریکی آن در فرکانس‌های نوری وابسته به فرکانس و تلفاتی خواهد بود:

$$\epsilon_l(\omega) = \epsilon'_l(\omega) - j \epsilon''_l(\omega), \quad (2)$$

شرط نوسان:

$$|\epsilon'_l(\omega) + 2\epsilon_m(\omega)|^2 + |\epsilon''_l(\omega)|^2 = \min. \quad (3)$$

این شرط بدان معنا است که باید $\epsilon_l(\omega)$ یک مقدار منفی بوده و

۱- مقدمه

پیشنهادی و قابلیت‌ها و انعطاف‌پذیری آن می‌شود. حل عددی نانوساختار و پرسه ساخت آن در بخش ۴ توضیح داده شده و جمع‌بندی مباحث در بخش ۵ آورده شده است.

۲- پلاسمون‌های سطحی محلی شده در نانوذره فلزی

روی سطح یک فلز با هدایت الکتریکی خوب، الکترون‌ها می‌توانند سرگردان و آزادانه حرکت کنند تا یک دریای دوپُعی از الکترون‌های آزاد را شکل دهند. این دریای الکترون‌های آزاد می‌تواند با امواجی که پلاسمون‌های سطحی نامیده می‌شوند، موجدار شود. نوری که به سطح یک فلز برخورد می‌کند می‌تواند دریای الکترون‌ها را به ارتعاش درآورد. اگر فرکانس نور تابشی به فلز به طوری با فرکانس تشديد پلاسمون‌های سطحی تطبیق شود، اثر عجیبی پدید می‌آید. پلاسمون‌های سطحی در رویه یک ذره یا ورقه فلزی انرژی الکترومغناطیسی نور را جمع کرده و حول برjestنگی‌ها یا حفره‌ها آنرا متتمرکز می‌کنند. برjestنگی‌ها یا حفره‌ها، ممان انرژی پلاسمون‌های سطحی را به طوری تنظیم می‌کنند که با نور تابشی تطبیق یابد. از آنجائی که پلاسمون‌های سطحی انرژی الکترومغناطیسی را به داخل یک حجم خیلی ریز متتمرکز می‌کنند، یک میدان الکتریکی قوی ایجاد می‌شود که کلید کاربردهای زیادی است [۶، ۲].

نانوساختارهای فلزی خواص نوری پیچیده و جالبی از خود نشان می‌دهند. برجسته‌ترین پدیده در این ساختارها، تشید الکترومغناطیسی بواسطه نوسان‌های منظم و بهم پیوسته الکترون‌های هدایتی یعنی پلاسمون‌های سطحی است. مودهای پلاسمونی در تعداد خاصی از ساختارها و در فلزهای مختلف به خصوص در فلزهای از قبیل طلا و نقره وجود دارند. اگر این مودها برروی فصل مشترک فلز- دی‌الکتریک ایجاد شوند، پلاسمون‌های سطحی و اگر در نانوذره‌ها^۹ فلزی ایجاد شوند، پلاسمون‌های ذره‌ای^{۱۰} یا پلاسمون‌های محلی شده نامیده می‌شوند. تحت شرایط معینی پلاسمون‌ها باعث می‌شوند که در این ساختارهای نانویی پدیده‌های همچون: پراکنده‌گی قوی، جذب و افزایش محلی میدان الکترومغناطیسی اتفاق بیفتدند.

۲-۱- مدل ریلی^{۱۱}

با ارائه یک مدل ساده می‌توان خواص زیادی از پلاسمون‌های ذره‌ای را در نانوذرات فلزی شناخت. با توجه به اینکه قطر ذره نانویی با عمق نفوذ امواج الکترومغناطیسی در فلزات هم مرتبه است، نور محرك قادر است به داخل ذره نفوذ کند. میدان داخل ذره الکترون‌های هدایتی را به هم و با توجه به بارهای مثبت ثابت یون‌ها شیفت می‌دهد. الکترون‌ها در روی سطح یک طرف ذره تجمع می‌کنند. بین دو طرف ذره که بارهای مثبت و منفی جمع شده‌اند یک نیروی بازدارنده شکل می‌گیرد. اگر فرکانس نور محرك با فرکانس ویژه این نوسانات تجمعی برای باشد، حتی یک میدان تحریکی کوچک باعث یک تشید قوی می‌شود.

در سال‌های اخیر توجه ویژه‌ای در علوم مختلف به خواص و رفتار نوری نانوذره‌ها و نانوساختارهای فلزی به عنوان عناصر پایه‌ای در تکنولوژی نانوپیک و نانوفوتونیک شده است [۱۵-۱۶]. نانوذره‌های فلزی بستر مناسبی برای نوسان میدان‌های نوری محلی و بهره دادن به باسخ الکترومغناطیسی هستند. تابش نور و یا یک موج الکترومغناطیسی باعث تحریک پلاسمون‌های سطحی و ایجاد حالت تشید در سطح نانوذره‌های فلزی می‌شود [۶]. ساختارها و قطعه‌های نوری نوین مختلفی از جمله: موجبرها، نانولنزها، لنزهای کامل^۴، فراماده^۵ الکتریکی و مغناطیسی، تقسیم‌کننده‌های توان، تزویج کننده‌ها، مدولاتورها و سوئیچ‌های نوری بر اساس عناصر نانوذره‌های فلزی و ترکیب آنها، پیشنهاد و ساخته شده‌اند [۱۶-۷].

نانوتکنولوژی در حوزه نور یا نانوپیک درجه‌های را به مباحث جدید نظری و عملی و همچنین کاربردهای نو باز می‌کند. در نانوپیک قابلیت دستکاری در ساختار اتم‌ها و مولکول‌های مصنوعی که اندازه‌ای در حد چند آنگstrom (۱۰^{-۱۰} متر) یا چند نانومتر دارند، امکان کنترل و دستکاری بعضی از رفتارهای طبیعی حاکم بر اندرکنش نور با مواد ساخته شده صنعتی^۶ و در نتیجه خواص نوری آنها را افزایش می‌دهد. بنابراین با مطرح شدن مواد پیشرفته صنعتی با قابلیت‌های ویژه در تکنولوژی نوین، قطعات نو با کاربردهای ویژه پدیدار می‌شوند [۹-۱۰]. در راستای برداشتن بعضی محدودیت‌ها در اندازه و ساختار قطعات نوری برای ساخت و توسعه قطعات و مدارات مجتمع نانوفوتونیک لازم است که انرژی الکترومغناطیسی در یک سطح زیر حد تفرق نور^۷ هدایت شده و همچنین اطلاعات نیز در یک فضای کوچکتر از طول موج نور بتوانند پردازش شوند [۱۴]. بنابراین در نانوپیک و نانوفوتونیک به ساختارها و مواد جدید (با فیزیک جدیدتری نسبت به فیزیک ساختارهای معمول هدایتی و پردازشی امواج) برای غلبه بر DLL و محدودیت‌های دیگر نیاز است. نیل به این اهداف و توسعه نانوتکنولوژی در مباحث نور و فوتونیک بدون توجه به پدیده پلاسمونیک در نانوذره‌ها، نانورشته‌ها و نانوزنجره‌های فلزی غیر ممکن به نظر می‌رسد. به همین علت یک نانوکره، نانودیسک و نانونوار فلزی یا یک آرایه از آنها که با تکنیک‌های امروزی به سادگی قابل ساخت هستند [۵]، کاربردهای بسیاری در نانوپیک و نانوفوتونیک پیدا کرده‌اند.

در این مقاله یک نانوساختار ساده بر اساس یک زوج نانو دیسک از جنس طلا با تغذیه انتهایی بررسی شده و کاربرد آن در پالایش^۸ بازه نوری برای اولین بار مطرح شده است. اندرکنش الکترومغناطیسی دو نانو دیسک که در فاصله کمی از هم قرار دارند، باعث هایبریداسیون مودهای پلاسمونی ساختار شده و دو مود با رفتار دوگانی توسط موج تابشی تحریک می‌شوند که در طراحی نانوفیلتر پیشنهاد شده بکار گرفته می‌شوند. مقاله شامل ۵ بخش است که در بخش بعدی به بررسی پلاسمون‌های سطحی و ذره‌ای در نانوذره‌ها با مدل‌های فیزیکی، ریاضی و الکتریکی پرداخته شده است. بخش ۳ شامل توصیف طرح نانوفیلتر

4 Perfect lens

5 Metamaterial

6 Artificial

7 Diffraction limit of light: DLL

8 Filtering

9 Nanoparticles

10 Particle plasmons

11 Rayleigh



طراحی و ساخت یک نانوفیلتر نوری بر اساس نوسان پلاسمون‌های سطحی

توكل پاکیزه

دانشکده مهندسی برق، دانشگاه صنعتی خواجه نصیر الدین طوسی، تهران، ایران
گروه فن آوری ارتباطات نوری، پژوهشکده ارتباطات، مرکز تحقیقات مخابرات ایران، تهران، ایران
دانشکده مهندسی فیزیک و میکروالکترونیک، دانشگاه صنعتی چالدرم، گوتینبرگ، سوئد

Pakizeh@eetd.kntu.ac.ir

نصرت ا. گرانپایه

محمد ص. ابریشمیان

دانشکده مهندسی برق، دانشگاه صنعتی خواجه نصیر الدین طوسی،
دانشکده مهندسی برق، دانشگاه صنعتی خواجه نصیر الدین طوسی،
تهران، ایران
granpaye@eetd.kntu.ac.ir msabrieh@eetd.kntu.ac.ir

تاریخ دریافت: ۱۳۸۷/۶/۳۰ - تاریخ پذیرش: ۱۳۸۸/۲/۱

چکیده - با بکارگیری نانو دیسک‌های فلزی با تغذیه انتهایی و بر اساس نوسان پلاسمون‌های سطحی محلی^۱ یک نانوفیلتر ساده و مؤثر در فرکانس‌های نوری طراحی و با استفاده از تکنیک نانولیتوگرافی حفره-ماسک^۲ ساخته شده است. مفاهیم فیزیکی و فیلترینگ نانوساختار با استفاده از تقریب الکتریسیته شبه‌سازکن و مدار معادل الکتریکی نانوساختار بررسی شده است. رفتار الکترومغناطیسی نانوفیلتر پیشنهادی با روش تفاضل محدود حوزه زمان پاشنده^۳ شبیه‌سازی شده است. پاسخ فرکانسی نانوفیلتر معرفی شده قابل تنظیم در بازه طول موج‌های نوری است. نتایج بدست آمده از مدل سازی و شبیه‌سازی با نتایج آزمایشگاهی هم خوانی دارند.

کلید واژه - پلاسمون‌های سطحی، نانوساختار، مدل ریلی، نانوفیلتر نوری، نانو دیسک فلزی، D-FDTD

Abstract- Based on the metal nanodisks arranged in the longitudinal configuration and their coupled localized surface plasmon resonances, a simple optical nanofilter is designed and fabricated using the hole-mask nanolithography technique. The filtering and physical concepts of the nanostructure are discussed using the quasi-static approximation and the circuit model. The optical properties of the proposed nanofilter are investigated using the dispersive finite-difference time-domain method. The spectral response of the filter is tunable in the considered optical range. The model and simulations results agree with the experiments.

1 Localized surface plasmons: LSPs

2 Hole-Mask: HM

3 Dispersive finite-difference time-domain: D-FDTD